



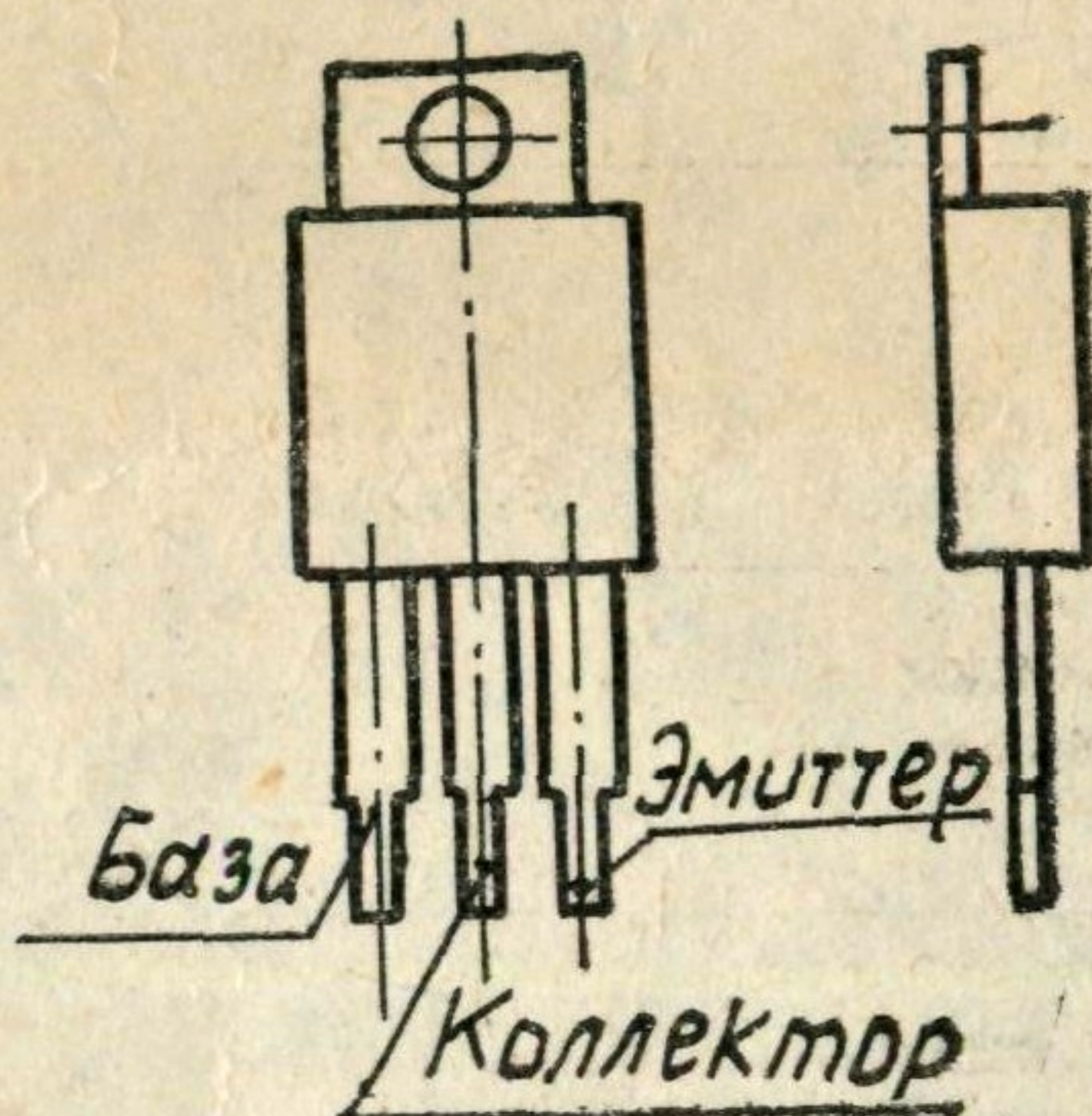
# Транзисторы КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г

## ЭТИКЕТКА

Кремниевые меза-планарные составные п-р-п мощные транзисторы КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г в пластмассовом корпусе предназначены для работы в усилителях низкой частоты, ключевых схемах.

Вид климатического исполнения УХЛ 3.1, 5.1

Корпус типа КТ-28-2 по ГОСТ 18472-82



Масса транзистора не более 3 г

Таблица 1

Основные электрические параметры при  $T_{корп.} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначен.	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ( $I_{кэ} = 3 \text{ В}$ , $I_{к} = 3 \text{ А}$ )	$\beta_{21э}$	750	—
Обратный ток коллектора, мА $I_{кб} = 100 \text{ В}$ для КТ829А $I_{кб} = 80 \text{ В}$ для КТ829Б $I_{кб} = 60 \text{ В}$ для КТ829В $I_{кб} = 45 \text{ В}$ для КТ829Г	$I_{кбо}$	—	0,2
		—	0,2
		—	0,2
		—	0,2
Обратный ток эмиттера ( $I_{эб} = 5 \text{ В}$ , $I_{к} = 0$ ), мА	$I_{эбо}$	—	2,0
Граничное напряжение, В для КТ829А $L = 40 \text{ мГн}$ для КТ829Б для КТ829В $I_{к \text{ нас}} = 0,3 \text{ А}$ для КТ829Г	$I_{кэо гр}$	100	—
		80	—
		60	—
		45	—
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ( $I_{к} = 3 \text{ А}$ , $I_{б} = 0,012 \text{ А}$ ), В	$I_{кэ \text{ нас}}$	—	2



Напряжение насыщения база-эмиттер ( $I_k = 3$ А, $I_b = 0,012$ А), В	$I_{бэ\text{ нас}}$	—	2,5
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ( $I_{кэ} = 3$ В, $I_k = 3$ А, $f = 10$ мГц)	( $h_{21э}$ )	0,4	—
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА $I_{кэ} = 50$ В для КТ829А $I_{кэ} = 40$ В для КТ829Б $I_{кэ} = 30$ В для КТ829В $I_{кэ} = 22$ В для КТ829Г	$I_{кэо}$	— — — —	0,5 0,5 0,5 0,5

Таблица 2

Предельно допустимые режимы эксплуатации при  $T_{\text{корп.}} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ 

Наименование параметра (режим и условия измерения), единица измерения	Буквенное обозначен.	Норма			
		КТ829А	КТ829Б	КТ829В	КТ829Г
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$I_{кб\text{ max}}$	100	80	60	45
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В	$I_{кэо\text{ max}}$	100	80	60	45
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$I_{эб\text{ max}}$	5	5	5	5
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_k\text{ max}$	8	8	8	8
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А ( $\tau_{\text{и}} \ll 500$ мкс, $Q \geq 10$ )	$I_{к, \text{и}}\text{ max}$	12	12	12	12
Максимально допустимый постоянный ток базы, А	$I_b\text{ max}$	0,2	0,2	0,2	0,2
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора ( $t_{\text{корп.}} \leq 25^\circ\text{C}$ , $I_k = 7,5$ В, $I_k = 8$ А), Вт	$P_k\text{ max}$	60	60	60	60
Максимально допустимая температура перехода, $^\circ\text{C}$	$t_n\text{ max}$	150	150	150	150



Содержание драгметаллов в 1000 транзисторов:

Золота — 0,3347 г

Содержание цветных металлов и их сплавов в 1000 шт. транзисторов

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса, г
Медь	МОб	1820 г

#### Сведения о приемке

Транзисторы КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г соответствуют техническим условиям  
аА0.336.292ТУ

Штамп ОТК



Штамп  
Государственной приемки



#### Указания по эксплуатации

Указания по применению и эксплуатации транзисторов по ГОСТ И630-84,  
ОСТ И 336.907.0-79.

Транзисторы необходимо применять с теплоотводами. Крепление транзисторов к теплоотводам должно обеспечивать надежный тепловой контакт. Для улучшения теплового контакта необходимо наносить на нижнее основание корпуса транзистора жидкость ПМС-100 по ГОСТ 13032-77 или другую теплопроводящую смазку.

При пайке выводов температура корпуса транзистора не должна превышать 85°C.

Допускается формовка выводов транзисторов в направлении, перпендикулярном плоскости его основания. Минимально допустимое расстояние от корпуса до места изгиба 3 мм.

Формовку проводить с обязательной фиксацией выводов. Место фиксации — между корпусом и местом изгиба.